

2SA606, 607 / 2SC959, 960

PNP/NPN エピタキシャル形シリコントランジスタ /

PNP/NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR

低周波増幅用 / Audio Frequency Amplifier

特 徴 / FEATURES

- ・実効出力30~50Wのステレオアンプのドライバとして最適。
Suitable for Driver of 30 to 50 watts Audio Amplifiers.
- ・電流増幅率の電流に対するリニアリティがよい。
Excellent Current gain linearity.

絶対最大定格 / ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T_a = 25℃)

項 目	略 号	2SA606	2SA607	2SC559	2SC960	単位
コレクタ・ベース間電圧	V _{CEO}	-100	-100	120	120	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEO}	-80	-80	80	80	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EB0}	-5.0	-5.0	5.0	5.0	V
コレクタ電流 (直流)	I _{C(DC)}	-0.7	-0.7	0.7	0.7	A
コレクタ電流 (パルス)	I _{C(pulse)*}	-1.2	-1.2	1.2	1.2	A
全損失	P _T (T _C =25℃)	0.7	1.0	0.7	1.0	W
ジャンクション温度	T _J	150				℃
保存温度	T _{stg}	-65~+150				℃

* PW ≤ 10ms, duty cycle ≤ 50%

電気的特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_a = 25℃)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタシャ断電流	I _{CBO}	V _{CB} = 80V, I _E = 0			3.0	μA
エミッタシャ断電流	I _{EB0}	V _{EB} = 5.5V, I _C = 0			3.0	μA
直流電流増幅率	h _{FE1}	V _{CB} = 5.0V I _C = 10mA*	20			
	h _{FE2}	V _{CB} = 5.0V I _C = 200mA*	40	80	200	
コレクタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C = 500mA I _B = 50mA*			2.0	V
利得帯域幅積	f _T	V _{CB} = 10V I _C = 100mA	50			MHz
コレクタ容量	C _{ob}	V _{CB} = 10V, I _E = 0			50	pF

* パルス測定 PW ≤ 350μs duty cycle ≤ 2%/pulsed

h_{FE} 区分/h_{FE} classification

h_{FE2} / N : 40~80 M : 60~110 L : 90~150 K : 130~200

外形図 / PACKAGE DIMENSIONS (Unit:mm)

